BEST AVAILABLE CO

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-293788

(43)Date of publication of application: 25.12.1991

(51)Int.CI.

H01S 3/07 C03C 3/32 C03C 4/12 G02B 6/00 G02B 6/00 G02F 1/35

G02F 1/35 H01S 3/17

(21)Application number: 02-095112

02 033112

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

12.04.1990

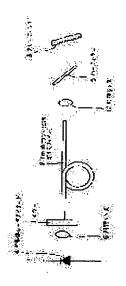
(72)Inventor: SUGAWA TOMONORI

MIYAJIMA YOSHIAKI KOMUKAI TETSUO

(54) OPTICAL FIBER TYPE LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To realize continuous oscillation at room temperature by opposing two reflectors through an active medium containing laser active ions and composing the active medium of a fluoride glass fiber. CONSTITUTION: In an optical fiber type laser comprising two reflectors opposing through an active medium containing laser active ions, the active medium is composed of a fluoride glass fiber 2 containing less than 1mol% of TmF3. Upon pumping with the beam from a semiconductor laser diode 4, light is spontaneously emitted in the fluoride fiber 2 to which Tm is added and temporarily converted through an objective lens 6' into a parallel beam which is then passed through a half mirror 5 and impinged on a grating 3. Light having specific wavelength is selectively returned through the grating 3 to the fluoride fiber 2 to which Tm is added and reflected on the mirror 1 thus constituting an optical feedback system. Consequently, semiconductor pumping and continuous oscillation at room temperature are realized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAACIaGwzDA403293788P1.htm

of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平3-293788

(43) 公開日 平成3年(1991) 12月25日

(51) Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H 0 1 S	3/07		•				
C 0 3 C	3/32						
C 0 3 C	4/12					,	
G 0 2 B	6/00	376					
G 0 2 F	1/35	501					
	審査請求	未請求 請求	項の数 1			(全4頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特層	顏平2-95112		(71) 出願人	999999999	1	
					日本電信管	電話株式会社	
(22) 出願日	平月	成2年 (1990) 4月	12日		東京		
				(72) 発明者	須川 智規	見	
					*		
•				(72) 発明者	宮島 義明	召	
					*		
				(72) 発明者		T.	
	•				*		
-	-	,					
			•	1			

(54) 【発明の名称】光フアイバ型レーザ

1

(57) 【要約】

【産業上の利用分野】光ファイバ型レーザに関する 【目的】半導体励起が可能で、かつ、室温で連続発振 し、さらに発振波長同調範囲または発振スペクトル幅が 0.1 μm程度の光ファイバ型レーザを提供する

【効果】本発明の光ファイバ型レーザはTm添加フッ化物ファイバの蛍光スペクトルが2. 3μ m帯の赤外域にあり、フッ化物ファイバの2. 55μ mでの最低損失波

長に近い。また半導体レーザ励起によりレーザ出力が得られるため、室温発振かつ連続発振が可能となる 【特許請求の範囲】

【請求項1】1)レーザ活性イオンを含む活性媒質と、該活性媒質を挟んで対向する2個の反射鏡とを有する光ファイバー型レーザにおいて、前記活性媒質が1mo▲%以下のTmF₃を含むフッ化物ガラスファイバからなることを特徴とする光ファイバ型レーザ。

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-293788

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月25日

H 01 S 3/07 7630-4M 9017-2K 9017-2K

G 02 B 6/00

E Z*

(全4頁)

審査請求 未請求 請求項の数 1

60発明の名称

光フアイパ型レーザ

②特 願 平2-95112

22出 願 平2(1990)4月12日

Ш 個発 明 者 須

智 規

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

個発 明 호

昭 鋑

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

個発 明 哲 郎 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

日本電信電話株式

会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

の出願 日本電信電話株式会社 19代理人 弁理士 谷

最終頁に続く

眼

1、発明の名称

光ファイバ型レーザ

2. 特許請求の範囲

1) レーザ活性イオンを含む活性媒質と、該活性 物質を挟んで対応する2個の反射鎖とを有する 光ファイバ型レーザにおいて、前記活性媒質が leoe%以下のTeF。を含むフッ化物ガラスファイ バからなることを特徴とする光ファイバ型レー

(以下糸白)

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光ファイバ型レーザに関し、特に小型 にして発振波長同調範囲が広く、または発振スペ クトル幅が広い光ファイバ型レーザに関するもの である.

「従来の技術」

従来、発展波長同調が可能な関体レーザとして は、『lサファイアレーザ、アレキサンドライトに Crを添加したレーザ、カラーセンタレーザ。光 ファイバのコア部にNd**を添加した光ファイバ型 レーザがあった。Tiサファイアレーザでは0.68~ 1.05gm.アレキサンドライトレーザは0.72~0.78 uu の間で発振波長同調が可能であり、カラーセ ンタレーザにおいては1.4 ~3.8 μα の広い範囲 で発振波是周調が可能である。しかしながらだサ ファイアレーザでは大出力のArイオンレーザを励 起用光源として用いるため装置が大型化し、また アレキサンドライトレーザにおいても同様の問題

特別平3-293788 (2)

が存在している。カラーセンタレーザについては 装置の大型化のみならず結晶を液体窒素で冷却し なければならない等の問題がある。

一方、石英系光ファイバのコア部に微量のNd_□O。を添加した光ファイバ型レーザにおいては、半導体レーザダイオードによる励起により発版波長範囲が 1 μ = 付近で塩温温視発版が可能であり、全体がコンパクトであるという利点を有している。

[発明が解決しようとする課題]

現在光通信用媒体として用いられている石英系ファイパは 1.3 μ m 及び 1.55 μ m に最低損失の窓があるが、その被長における損失値は次世代光通信用媒体として期待されているファ化特系ファイパの最低損失波長 2.55 μ m における損失値より大きい。そのためファ化物系 ガラスを用いて長距離・大容量伝送を目ざした開発がいくつかの研究機関で進められている。しかしながら 2.5 μ m 帝の光通信に必要な光源はカラーセンタレーザを除

いて他に存在しない。しかし、カラーセンタレーザを用いると、上に述べた様に極めて大きくなってしまうという問題がある。 2.55 μ ■ 動作の半導体レーザは現在富温速焼発振は不可能であり、室温で連続発振する通信用光源の実現が望まれてい

本発明は半導体励起が可能で、かつ、室温で連続発振し、さらに発振波長周調範囲または発振スペクトル幅が 0.1μm 程度の光ファイバ型レーザを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本発明光ファイバ型レーザはレーザ活性イオンを含む活性 媒質と、該活性物質を挟んで対向する2個の反射 鏡とを有する光ファイバ型レーザにおいて、前記 活性媒質が1mo4%以下のTeFaを含むファ化物ガラスファイバからなることを特徴とする。

【作用】

本発明はTaを添加したファ化物ガラスの蛍光特性を詳細に検討した結果に基いてなされたものである。ファ化物ガラスにTaを添加した試料をその吸収ビークに一致する液長 (例えば、A & GaAs系半導体レーザの発振液長、0.79μa)を持つ光により励起すると液長0.82μa、1.5μa、1.9μa、2.3μa にピークを持つ蛍光が生じる。特に液長2.3μa の蛍光は超長液長伝送システムを考えた場合、非常に重要である。またそこでの蛍光の広がりを観察した結果約0.1μa 程度の広がりがみられる。

さらに蛍光の広がりの範囲内でグレーティング により選択的に波長を選ぶことにより発振波長向 翼が可能となる。

従来このように室温で2.3 μm に免扱波長を持つようなレーザはなかった。

(実施例)

以下に図面を参照して本発明の実施例を説明す

δ.

第1図は本発明の実施例の構成を示す図であ り、1は誘電体多層膜からなるミラー、2はTa还 加フッ化物ガラスファイバ、3はグレーティン グ、4は半導体レーザ、5はハーフミラー、6お よび6′は対物レンズである。ここでTm添加ファ 化物ガラスファイバはカットオフ被長2.23μa, コア、クラッドの比屈折率差0.5 %。コア径およ びクラッド径がそれぞれ6.5 μm および125 μm のものを用いた。ファ化物ガラスの組成はZrF』= 57mol % . Baf = 34mol % . Laf = 5 mol % . Alf,= 4 mol % であり、これに1250ppm のTof. が添加されている。ファ化物ガラスファイバ2 の長さは数10cmである。ミラー1は波長0.7~ 0.8 μα での透過率が99.5%以上で、かつ波長 2.27~2.40μαでの反射率が99%以上の特性を 持っている。半導体レーザダイオード4から拡長 <u>D. 79 g B パワー30 g R</u>の光を励起用として、対物レ ンズ6を介してTa添加ファ化物ファイバ2のコア 郎に入射させた。

特間平3-293788 (8)

Te添加ファ化物ファイバ2内で半線体レーザダイオードの光により勘配されて生じた自然放出光は対物レンズ6 により一度平行ピームにされてからハーフミラー5を通過し、グレーティング3により被長1.27~2、40μmの間の特定の被長のみが選択的にTe添加ファ化物ファイバ2に戻され、次にミラー1で反射され、光のフィードバック系が構成される。

この簡果、グレーティング3により選択された 特定の放長の光に対し誘電放出が生じレーザ発掘 する。レーザ発振光の一部はハーフミラー5によ りレーザ共振器の光軸と直角の方向に取り出され る。

第2図にこの実施例のTo試加フッ化物ファイバの変光スペクトル(曲線 A) および発掘スペクトル(曲線 A) および発掘スペクトル(曲線 B) を示した。この実施例では30mmの単導体レーザダイオード 4 からの励起光に対し、被 長2.27~2.40μmの範囲で最大2mmのレーザ発振を実現した。

本発明において用いられるフッ化物ガラスは

室温発振かつ運統発振が可能である。 従ってファ 化物ファイバを伝送媒体として組長波長帯システ ムの光源として用いることが可能である。

さらにグレーティングを用いることにより 2.27~2.40μm間で発掘波長を任意に選択するこ とができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の構成を示す図、

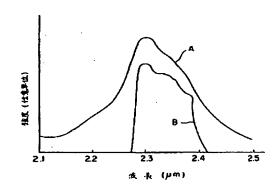
第2回は本発明実施例の発光スペクトルおよび 発掘スペクトル特性図である。

- 1 ... 2 5 -- .
- 2 … Te添加フッ化ガラスファイバ。
- 3 …グレーティング、
- 4…半導体レーザダイオード、
- 5 … ハーフミラー、
- 6,6 …対物レンズ。

2rF・-BaF・-LaF = -AAF - 系ガラスが好ましく、特に 2rF・: 50~58mo & ※・BaF =: 33~36mo & ※・LaF・: 3~6 mo & ※・LaF・: 3~6 mo & ※・A&F・: 2~6 mo & ※の範囲がよい。この組成範囲外では損失が大きくなる。系加される TaF・の量は 1 mo & ※以下であり、1 mo & ※をこえると決度消光によって効率が落ら、さらにファ化物ガラス中にクラスタ化が生じる。ファ化物ガラスファイバの諸元、すなわちコア径およびクラッド径、コア・クラッドの比屈折率差 およびカットオフ波長が実施例に示した値に限定されないことは言うまでもない。 ff ましい 比屈折率 差は、0.3~0.5 % であり、 ff ましいカットオフ波長は 2.1~2.3 μm である。

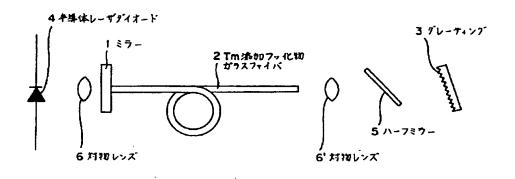
[発明の効果]

以上説明したように、本発明の光ファイバ型 レーザはTe添加ファ化物ファイバの蛍光スペクト ルが2.3 μ = 帯の赤外域にあり、ファ化物ファイ パの2.55μ = での最低損失被長に近い。また半導 体レーザ勘起によりレーザ出力が得られるため、



本地明実施的の発光スペクトルおよび発展スペクトル特性図第 2 図

特開平3-293788 (4)



本発明実施例の構成を示す図 第 I 図

第1頁の続き			
Solnt. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	
C 03 C 3/32 4/12		6570-4 G 6570-4 G	
G 02 B 6/00	376 B	7036-2K	
G 02 F 1/35	5 0 1 5 0 5	7246—2K 7246—2K	
H 01 C 2/17			

フロントページの続き

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 S 3/17

.